



UOT621.004.37

<https://doi.org/10.30546/678209.2025.01.036>

KARBON NANOBORUCUQLAR VƏ KOMPÜTERLƏRİN GƏLƏCƏYİ

¹Aslanov Əkrəm Əhməd oğlu, ²Kəsəmənli Hamlet Cümşüd oğlu,
³Yaqubova Lalə Emin qızı

^{1,3}Gəncə Dövlət Universiteti, ²Azərbaycan Texnologiya Universiteti

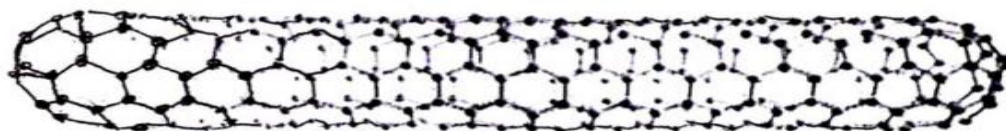
¹aslanov.akram@mail.ru; ²hamlet.kesemenli@mail.ru; ³lalayaqubova@mail.ru

Xülasə. Müasir kompüterlərin əsasını yarımkeçirici tranzistorlardan quirlənmiş məntiq sxemləri təşkil edir. Bu elementlərin indiki yaradılma texnologiyası - silikon çiplərdə bir-birindən eni minimum 20 nanometrə qədər (bundan daha sıx olanda elektronlar tranzistorun ayırıcı təbəqələrini deşə bilər - cıqırlar arasında qısa qapanma yaranır) aralı yerləşdirilmiş cıqırlı mikrosxemlərdir. Dünyada artıq ən kəsiyi nanometr olan karbon nanoborucuqlar alınmışdır və ondan istifadə olunmaqla tranzistor yaradılmışdır. Bu texnologiyanın əməli yaddaş qurğularında istifadəsi, yaddaşın sıxlığını və sürətini 10-larla dəfə artırma bilər.

Acar sözlər: kompüter, elektron yaddaş, tranzistor.

Giriş. 1985-ci ild Robert Kerl, Harold Kroto və Riçard Smolli karbon atomlarının yeni halını – fullerenləri kəşf etdilər. Onlar bu kəşfə görə 1996-cı ildə Nobel mükafatına layiq görüldülər. Fullerenin molekulunun əsasını karbon atomları təşkil edir. Bu kimyəvi elementin fərqləndirici xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, müxtəlif tərkibli maddələrlə, müxtəlif quruluşda asanlıqla birləşir. Kimyadan məlumdur ki, karbonun əsasən iki allotrop halı - qrafit və almaz mövcuddur. Fullerenlərin kəşfindən sonra karbonun yeni bir allotrop halı da aşkar edildi.

Fulleren molekulunun quruluşunun tədqiqini davam etdirən Yaponiyalı professor S.İidzima 1991-ci ildə nanoborucuq adlanan uzun karbon silindrini müşahidə etmişdir (şəkil 1).



Şəkil 1. Karbon nanoborucuq.

Nanoborucuq – milyon karbon atomundan ibarət elə bir molekuldur ki, borunun diametri nanometr tərtibində, uzunluğu isə bir neçə on mikrondur. Borunun divarlarında karbon atomları düzgün altıbucaqlının təpə nöqtələrində yerləşir. Nanoborucuqların diametri tükəndən 100 dəfə kiçik olmasına baxmayaraq, davamlı və möhkəmdir. Poladdan 50 - 100 dəfə möhkəm, həm də sıxlığı poladdan altı dəfə kiçikdir. Nanoborucuqlar möhkəm rezin boruları xatırladır. Xarici mexaniki gərginlikdən borucuq qırılmaz, sınmır, sadəcə onun təşkil olunduğu atomlar öz yerini dəyişir. Onların elektrik, maqnit və optik xassələri də fərqlidir. Qeyri-adi elektrik xassələrinə malik olan nanoborucuqlar nanoelektronika üçün yaxşı materialdır.

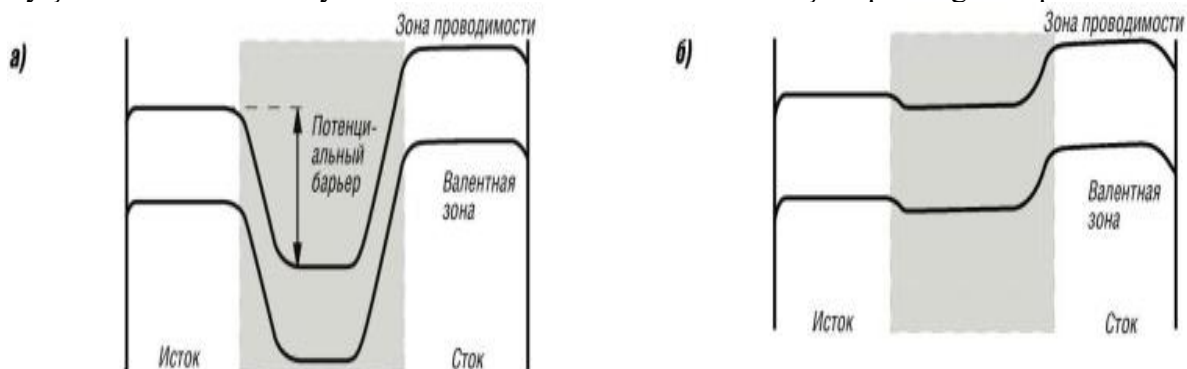
Karbon nanoborucuq (KNB) tranzistorlar. Aydın ki, mikrosxem istehsalı üçün indi istifadə olunan silikon bazalı ənənəvi texnologiyalar ölçülərinə (kiçikliyinə) görə artıq öz nəzəri sərhədlərinə (12 nanometr) çatmışdır. Mikrosxemlərin əsas funksional hissəsi olan tranzistorun ölçüləri isə molekulun ölçülərinə - nanometrlərə yaxınlaşmışdır. Deməli, silisium metal-oksid-yarımkeçirici erasını bitmiş hesab etmək olar. Bu istiqamətdə yeni texnologiya - tranzistorların silikon əvəzinə KNB bazasında hazırlanmasıdır. Belə tranzistorlar sələflərinə



nisbətən daha kiçik (molekul ölçülərinə yaxın) və daha tezişləyəndir (hesablamalara görə KNB-lər terrahers tezliklərində işləyə bilər - indiki kompüterlərdən 100 dəfələrlə çox).

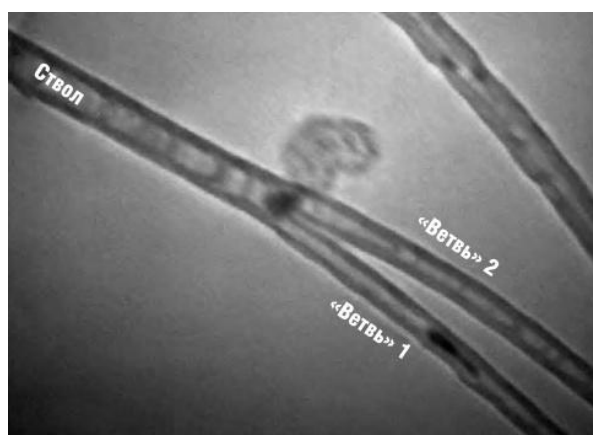
Bu tranzistorlar necə hazırlanır. Tranzistoru KNB-lərdən istifadə etməklə ənənəvi sahə tranzistorlarına analoji yaratmaq olar. Bunlarda ötürücü kanal kimi KNB-dən istifadə olunur (Şəkil 2).

Tranzistor aşağıdakı kimi hazırlanır: Silisium səthə mənşəb (stok) və mənbə (istok) olan elektrod cütü tozlandırılır. Onların arasına KNB yerləşdirilir. Səth özü sürgü(zatvor) rolu oynayır. Adi halda dəşiklər üçün sədd olduğu üçün kanal bağlıdır. Keçirici zona (Зона проводимости) və valent zona (валентная зона) eni bir neçə Ev olan qadağan zonası ilə ayrılır (şəkil 2a). Sürgüyə gərginlik versək KNB olan yerdə elektrik sahəsi yaranır və onun zona diaqramı dəyişir, KNB yaxşı keçiriciyə çevrilir (şəkil 2b). Beləliklə sürgüdə gərginliyi dəyişməklə KNB-da cərəyanı tənzimləmək olar - taranzistoru açmaq və bağlamaq olar.



Şəkil 2. Tranzistoun xarici sahəsiz (a) və xarici sahəli (b) zona diaqramları

KNB tranzistorların hazırlanma texnologiyaları silisium texnologiyalarına nisbətən daha sadədir. Bu tip tranzistorları KNB tərkibli “boya”nı çəkməklə yaratmaq olar. Hal-hazırda KNB tranzistorun bütöv (elektrodlu, izolyasiyalı və KNB kanallı) çapı texnologiyası da mövcuddur. Bundan əlavə Y – şəkilli KNB-lər sintez etmək mümkündür ki, heç bir əlavə elementdən istifadə etmədən tranzistor yaratmaq olar. Belə tranzistorun elektron mikroskopda alınmış fotosu şəkil 3-də göstərilir.



Şəkil 3. Y-şəkilli KNB trannzistor

Belə strukturun yaradılması üçün hazır KNB-nin üzərinə ikinci budağın (ветвь 2) yaranmasına xidmət edən katalitik aktiv titan nanozərrəcikləri tozlandırılır. KNB-nin



gövdəsinə gərginlik verəndə elektronların bir budaqdan o birinə axını dayanır. Elə ki, gövdənin potensialı 0 olur, budaqlarda cərəyan axını bərpa olunur. Beləliklə bu struktur sahə tranzistoru kimi fəaliyyət göstərir.

Mövzunun aktuallığı. Kompüterlərin funksional qurğularının – mikroprosessor və yaddaşın yeni texnologiyalı element bazası əsasında yaradılması, onların informasiya emal etmə sürətini onlarla dəfə artırmağa bilər. Müzakirə olunan karbon nanoborucuqlu tranzistorlardan məntiq sxemlərində istifadə, yeni – nanoelektronika nəslili kompüterlərin yaradılması deməkdir.

Tədqiqatın məqsədi. Kompüterlərin yaradılmasında tədqiq olunan yeni texnologiyaları araşdırmaq və bu tipli praktiki tədqiqatların aparılmasını stimullaşdırmaqdır.

Tədqiqat obyekti. Nanoborucuqlar əsasında yaradılmış tranzistorlar.

Tədqiqat metodu. Nanoelektronika sahəsində müxtəlif tədqiqatların nəticələrinin birlikdə analizi və bu istiqamətli perspektivlərin proqnozlaşdırılması.

Nəticə. Budaqlanmış KNB texnologiyası kompüterlər üçün ifrat kompakt və ifrat tezisləyən mikrosxemlərin yaradılmasına imkan yaradır. Bu texnologiyalardan istifadə olunmaqla yaradılan məntiq sxemlərinin əməli yaddaş qurğularında istifadəsi, yaddaşın sıxlığını və sürətini 10-larla dəfə artırmağa bilər.

Tədqiqat işinin tətbiqi əhəmiyyəti. KNB tranzistorların hazırlanma texnologiyaları silisium texnologiyalarına nisbətən daha sadədir. Materialşünaslıqda ən kəsiyi nanometr olan karbon nanoborucuqlar alınmışdır və fiziklər artıq ondan istifadə olunmaqla tranzistor yaratmışlar. Bu texnologiyanın əməli yaddaş qurğularında istifadəsi, yaddaşın sıxlığını və sürətini 10-larla dəfə artırmağa bilər. Bu istiqamətli tədqiqatların Azərbaycanda aparılması üçün şərait və perspektivlər var.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdinov, Ə.Ş., Səfərov, V.H. Elektron texnikasının materialları və nanotexnologiyanın əsasları. Bakı, 2010. 850s.
2. Paşayev, A.M., Ağayeva, S.X. Nanomateriallar, tədqiqat üsulları, cihazlar. Bakı, 2012.
3. Запороцкова И.В. Углеродные и неуглеродные наноматериалы и нанокompозитные структуры на их основе: строение и электронные свойства. Волгоград, 2009. 490 с.
4. <http://static.bsu.az/w27/Bakmuh/vlinhf/muh-3%20nhf.pdf>
5. <http://www.technet.az>

УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ И БУДУЩЕЕ КОМПЬЮТЕРОВ

Асланов А.А., Касаманли Г.Дж., Ягубова Л.Е.

РЕЗЮМЕ

Основой современных компьютеров являются полупроводниковые транзисторные логические схемы. Технология нынешнего поколения этих элементов представляет собой кремниевую микросхему, логические элементы и котором расположены на треках, расстояние между ними не менее 20 нм (ниже этого значения происходит короткое замыкание между треками). Используя углеродные нанотрубки уже создан транзистор с размером близким 1 нм. Использование этой технологии в запоминающих устройствах может увеличить плотность и быстродействие памяти десятки раз.

Ключевые слова: компьютер, электронная память, транзистор.

**CARBON NANOTUBES AND FUTURE OF COMPUTERS****Aslanov A.A., Kasamanli H.J., Yaqubova L.E.****SUMMARY**

The basis of modern computers is semiconductor transistor-derived logic schemes. The present generation technology of these elements is silicon chips that are spaced with a width of less than 20 nanometers (more closely interconnected with electrons, which breaks the separating layers of the transistor). In the world, carbon nanoscapilys have already been cut off and the transistor (metal-semiconductor) has been purchased. The use of this technology in practical memory devices can increase memory density and speed by over to 10 times.

Keywords: computer, electronic memory, transistor.

Redaksiyaya daxilolma 15.05.2024

Çapa qəbul olunma 12.12.2024

